

内置氮化镓功率因数校正转换芯片

产品概述：

DK8318 是一款工作在临界模式和断续模式的功率因数校正芯片，重载工作在临界导通模式，在负载减轻时无缝切换到断续导通模式。芯片内置了 700V/101mΩ 低内阻氮化镓功率管，芯片内置软启动、输入欠压保护、输入功率补偿、过温保护、输出欠压过压保护、过流保护等功能。DK8318 与后级的 FLYBACK、AHB、LLC 等芯片配合使用，可以实现高效可靠的电源方案，DK8318 的推荐功率范围为 180W 以内。

特点：

- 超低待机功耗 (25mW@115Vac, 39mW@230Vac) : 无需禁用 PFC 可满足 CoC V5 Tier2 和 DoE VI
- 宽母线电压输入 (85~265Vac)
- CRM、DCM 工作模式
- 谷底导通
- 输出电压分段功能 : (400Vdc@AC > 170V , 264Vdc@AC < 146V)
- 退磁检测无需辅助绕组
- 输入功率补偿
- 内置 700V/101mΩ 氮化镓功率管
- 内置多种保护功能：VCC 欠压保护、输出过流保护、输出欠压过压保护、过温保护和旁路二极管短路保护、RCS 电阻开路保护

典型应用：

- 电源适配器
- 计算机电源
- 打印机电源
- LED 驱动

丝印说明：

丝印	说明
DK	东科半导体
#	生产测试代码，有空格、“A~Z、*#△”不等
2501	2025 年第 1 批次
8318	产品型号
SATH0	订购代码
T01	芯片代码及芯片小批号，一般有“01~25”共 25 批

DK #2501

DK8318

• SATH0 T01

订购代码释义：

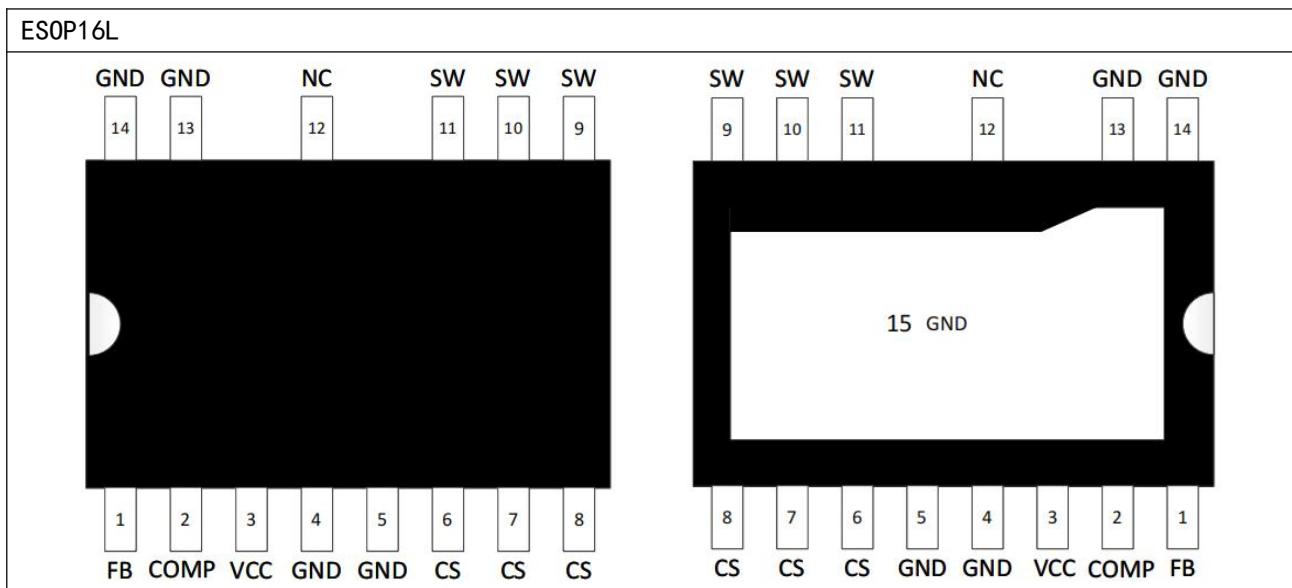
第一位：封装	第二位：主控版本	第三位：内置 GaN 规格	第四位：功能	第五位：预留
S:ESOP16L	A: 主控版本号为 A	T: 700V/101mΩ	H: 输出不分段	0: 预留
			L: 输出分段	

订购信息：

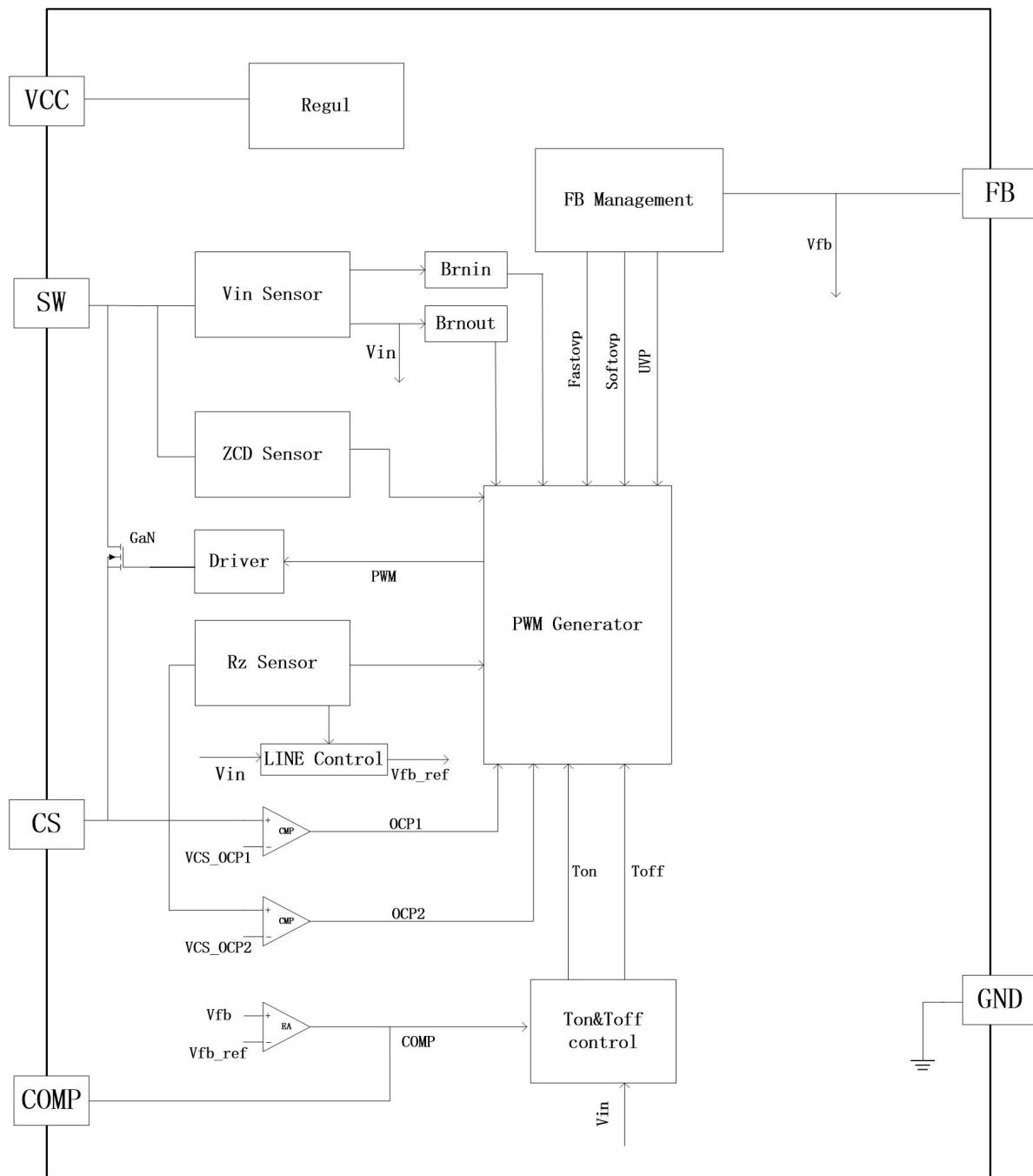
产品型号	订购代码	封装形式	内置 GaN 规格	包装形式
DK8318	SATH0	ESOP16L	700V/101mΩ	盘装，PCS/盘
DK8318	SATL0	ESOP16L	700V/101mΩ	盘装，PCS/盘

引脚功能说明：

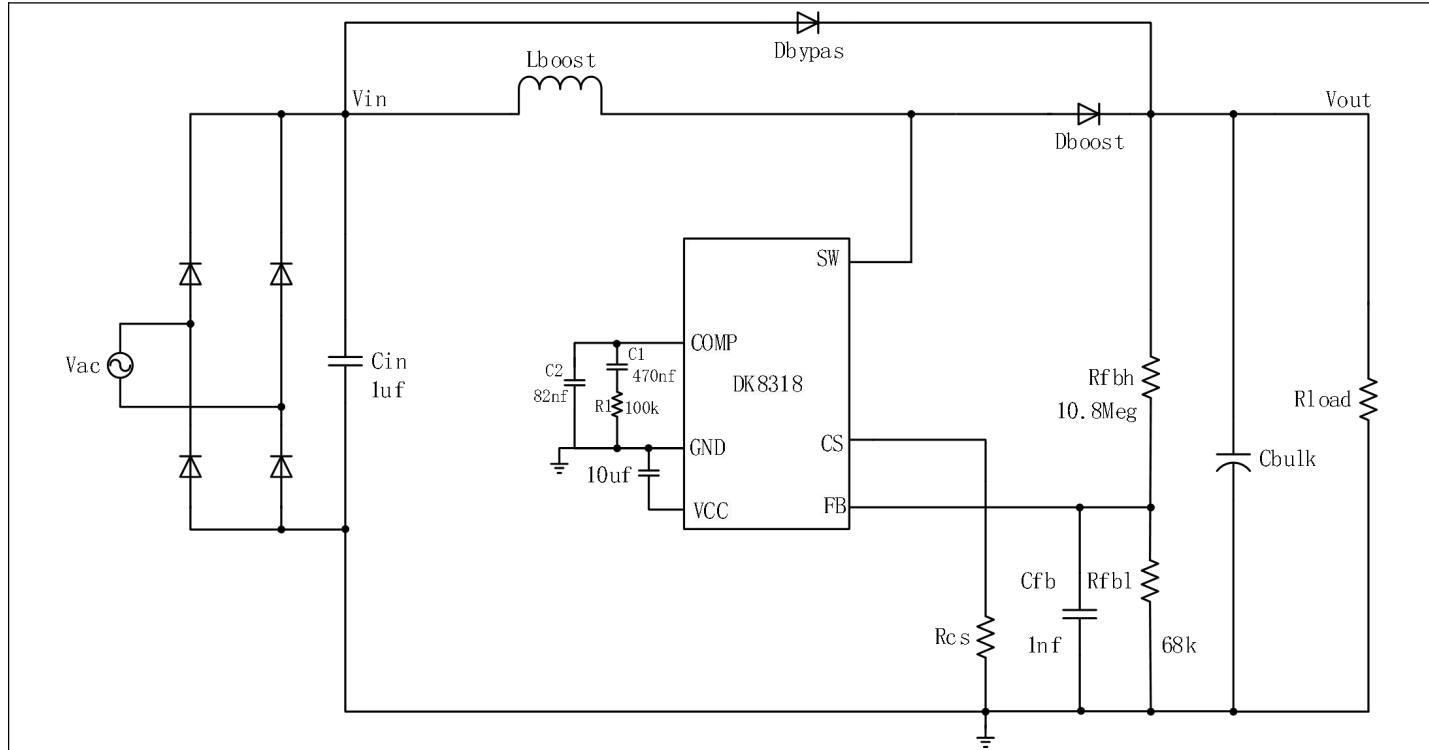
管脚序号	管脚名称	描述
1	FB	输出电压反馈引脚
2	COMP	EA 外部补偿引脚
3	VCC	芯片供电引脚
4, 5, 13, 14, 15	GND	芯片地
6, 7, 8	CS	电感电流采样输入引脚
9, 10, 11	SW	功率管漏极
12	NC	内部悬空



电路结构框图：



典型应用线路图：



极限参数：

项目	符号	最小值	最大值	单位
功率管耐压	SW	-2	700	V
饱和电流 ^① ($T_c=125^\circ\text{C}$)	I_{SAT}	10.5		A
漏源极连续电流	I_D		16	A
漏源极脉冲电流 ($T_c=25^\circ\text{C}$, $t_{\text{PULSE}}=10\mu\text{s}$)	$I_{D,\text{pulse}}$		32	A
漏源极脉冲电流 ($T_c=125^\circ\text{C}$, $t_{\text{PULSE}}=10\mu\text{s}$)	$I_{D,\text{pulse}}$		18	A
芯片供电引脚耐压	VCC	-0.5	36	V
电流检测引脚耐压	CS	-0.5	8.5	V
输出电压反馈引脚耐压	FB	-0.5	8.5	V
补偿引脚耐压	COMP	-0.5	8.5	V
储存温度范围	TSTG	-55	-155	°C
结温	TJ	-40	150	°C
焊接温度	TW		260/5S	°C
ESD	HBM (不包含 SW 引脚)	±2000		V
	HBM (SW 引脚)	±1000		V
	CDM	±500		V

注：最大极限值是指超过该工作范围，芯片有可能损坏。推荐工作范围是指在该范围内，器件功能正常，但并不完全保证满足个别性能指标。电特性

参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电参数规范。对于未给定上下限值的参数，该规范不予保证其精度，但其典型值合理反映了器件性能。

①: I_{SAT} 为氮化镓器件 125°C 下的最大饱和电流，器件饱和电流和器件温度成反比，使用时需要注意器件温度；参考以下详细介绍部分的 GaN 器件的电流能力的归一化曲线，可以根据上面的饱和电流数据进行折算；实际系统电流设置需要参考芯片的温度去考量。

电特性参数：(无特别说明情况下, $V_{CC}=18V$, $T_A = 25^{\circ}C$)

符号	描述	测试条件	范围			单位
			最小	典型	最大	
VCC 供电						
V_{CC_start}	V_{CC} 启动电压		10. 1	10. 8	11. 6	V
V_{CC_uvlo}	V_{CC} 欠压重启门槛电压		8. 5	9. 1	9. 8	V
I_{VCC_st}	V_{CC} 启动电流				120	uA
I_{VCC_op}	V_{CC} 工作电流				1	mA
输入电压检测						
$V_{IN_pk(brnIn)}$	判断 V_{IN} 上电成功时的 V_{IN} 电压		103	108	115	V
$V_{IN_pk(brnOut)}$	判断 V_{IN} 掉电时的 V_{IN} 电压		86	90	96	V
T_{ZCD}	过零检测到 GT 开始上升延迟时间			21		nS
COMP 调节与补偿						
GEA	误差放大器跨导增益			50		uA/V
GEA_DRE	DRE 状态时误差放大器跨导增益			300		uA/V
V_{comp_clamp}	COMP 钳位电压			5. 5		V
$V_{comp(stdh)}$	退出 STDBY 模式的电压阈值			820		mV
$V_{comp(stdl)}$	进入 STDBY 模式的电压阈值			700		mV
T_{smin}	两个 PWM 最短间隔时间			2		us
T_{onmax}	最大 T_{on} 开通时间	输入 85Vac		12. 8		us
$T_{onmax@175Vac}$	最大 T_{on} 开通时间	输入 175Vac		2. 66		us
CS 峰值电流检测						
$V_{CS}(ocp1)$	过流保护 OCP1 时 V_{CS} 阈值		450	500	550	mV
T_{leb_ocp1}	一级过流保护前沿消隐时间			300		ns
$V_{CS}(ocp2)$	过流保护 OCP2 时 V_{CS} 阈值			760		mV
T_{leb_ocp2}	二级过流保护前沿消隐时间			150		ns
FB 输出电压检测						
$V_{FB}(ref)$	FB 参考电压	$R_z=1K/R_z=4. 7K$, $I_{comp}=0uA$	2. 45	2. 50	2. 55	V
$V_{FB}(fovph)$	过压检测 FB 阈值	$R_z=1K/R_z=4. 7K$	2. 65	2. 72	2. 78	V
$V_{FB}(fovpl)$	过压恢复 FB 阈值	$R_z=1K/R_z=4. 7K$	2. 57	2. 64	2. 7	V
$V_{FB}(uvp)$	判断 V_{IN} 上电成功时的 FB 电压			500		mV
$V_{FB}(DREh)$	进入 DRE 状态时 FB 高阈值	$R_z=1K/R_z=4. 7K$		2. 58		V
$V_{FB}(DREl)$	进入 DRE 状态时 FB 低阈值	$R_z=1K/R_z=4. 7K$		2. 42		V
FB 输出电压检测 (AC<146V)						
$V_{FB_L}(ref)$	FB 参考电压	$R_z=2. 2K/R_z=10K$, $I_{comp}=0uA$	1. 62	1. 65	1. 68	V
$V_{FB_L}(fovph)$	过压检测 FB 阈值	$R_z=2. 2K/R_z=10K$	1. 81	1. 85	1. 89	V

Vfb_L(fovpl)	过压恢复 FB 阈值	Rz=2.2K/Rz=10K	1.76	1.8	1.84	V
Vfb_L(DREh)	进入 DRE 状态时 FB 高阈值	Rz=2.2K/Rz=10K	1.7	1.73	1.76	V
Vfb_L(DREl)	进入 DRE 状态时 FB 低阈值	Rz=2.2K/Rz=10K	1.54	1.57	1.6	V
内部过温保护检测						
Totp(in)	过温保护进入温度			150		°C
Totp(out)	过温保护退出温度			120		°C
功率管参数						
Rds_on	功率管导通内阻	Vgs=6V, Id=5A, Tj=25°C		101	130	mΩ
		Vgs=6V, Id=5A, Tj=150°C		230		mΩ
Coss	输出电容	Vgs=0V, Vsw=400V, F=100KHz	36.5			pF
Ciss	输入电容		101			pF
Crss	反向传输电容		0.4			pF
异常保护停止时间						
Tstop	STOP 时间		1.89	2.1	2.31	s

功能概述：

启动

芯片依靠后级的 VCC 供电，当 VCC 上电以后，检测到 VCC>Vcc_start 时，芯片内部控制电路开始工作。

输入电压上电检测 (Brownin)

上电后，芯片通过 HV 电压检测 Vin 电压，当检测到 Vin_pk>Vin_pk(brnln)，且同时满足 Vfb(fovpl)>Vfb>Vf(bvlp)，则判定为母线上电成功，开始输出 PWM。

输入电压掉电检测 (Brownout)

正常工作阶段，芯片通过 HV 引脚实时检测 Vin 电压；如果检测到 Vin_pk<Vin_pk(brnout)，判定此时输入电压处于欠压状态，并停止 PWM 输出，进入输入电压上电检测状态。

线电压功率补偿和导通控制(Ton 时间)

芯片通过 HV 引脚检测输入电压 Vin，根据 Vin 和 Comp 电压调整功率管 Ton 时间，这样确保最大输入功率和输入电压 Vin 无关，可以实现不同线电压下，最大输入功率的补偿。

谷底检测

在功率管关断后，电感进入退磁阶段，芯片通过 HV 引脚检测功率管漏源电压 Vds，当退磁结束时，在谷底开通功率管，减少开通损耗。

DCM 和 CRM 模式

芯片通过检测 COMP 电压，能够在负载较重时工作在临界连续模式 (CRM)，以提供良好的重载效率，而在轻载时会自动进入断续模式 (DCM) 模式，以此降低开关频率，实现良好的轻载效率。

输出电压分段功能

分段版本：芯片 HV 引脚检测输入电压 Vin，当输入电压小于 146Vac，FB 基准降到 1.65V，对应的典型输出电压为 264Vdc，可以有效降低 PFC 功率管在 90Vac 输入时的导通损耗；

当输入交流电压大于 170Vac 时，FB 基准恢复到 2.5V，对应的典型输出电压为 400Vdc；

固定输出版本：默认无输出电压分段功能，FB 基准默认 2.5V。

STDBY 模式

当芯片检测到 COMP 电压 Vcomp<Vcomp(stdl) 时，芯片进入 STDBY 模式；当芯片检测到 COMP 电压 Vcomp>Vcomp(stdh) 时，芯片退出 STDBY 模式。

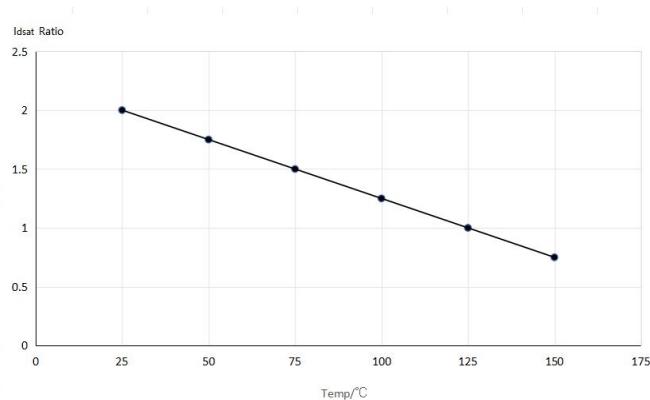
增强型 EA(DRE)

芯片采用增强型 EA 优化动态特性。当 FB 电压上升至 Vfb(DREh) 以上时，启动 EA 快速环路，加快环路响应速度，加速对 COMP 电压放电；当 FB 电压下降至 Vfb(DREL) 以下时，启动 EA 快速环路，加快环路响应速度，加速

对 COMP 电压充电。增强型 EA 加快了负载切换时的响应速度，提高系统的稳定性，降低器件应力。

GaN 器件的电流能力

对于氮化镓功率器件，温度是影响器件电流能力的重要因素，如图所示为器件电流能力与结温的归一化曲线，以 $T_J=125^{\circ}\text{C}$ 为基准，根据实际器件结温换算该温度下器件的电流能力。



输出过压保护 (FOVP)

芯片检测 $V_{fb} > V_{fb}(fovph)$ 时，停止 PWM 输出，检测 $V_{fb} < V_{fb}(fovpl)$ 后，允许 PWM 输出。

输出欠压保护

芯片检测到 $V_{fb} < V_{fb}(uvp)$ 时，停止 PWM 输出，进入输入电压上电检测。

VCC 欠压保护 (UVLO)

芯片检测到 $V_{CC} < V_{CC_uvlo}$ 时，停止 PWM 输出，进入到复位状态。

旁路二极管短路

芯片检测到旁路二极管短路，停止 PWM 输出，进入 STOP 模式。

过流保护 (OCP1、OCP2)

芯片通过 CS 引脚检测功率管的电流，来提供逐周期的电流限制，当 PWM 开通 T_{leb_ocp1} 后，CS 引脚检测到 $V_{cs} > V_{cs}(ocp1)$ ，触发 OCP1 保护并立即关断 PWM；当 PWM 开通 T_{leb_ocp2} 后，CS 引脚检测到 $V_{cs} > V_{cs}(ocp2)$ ，触发 OCP2 保护并立即关断 PWM，等待 1ms 后才允许再次开启 PWM。

当连续 3 个 PWM 都能检测到 $V_{cs} > V_{cs}(ocp2)$ ，芯片进入 STOP 模式。

RCS 电阻开路保护

芯片检测到 RCS 电阻开路，停止 PWM 输出，进入 STOP 模式。

过温保护 (OTP)

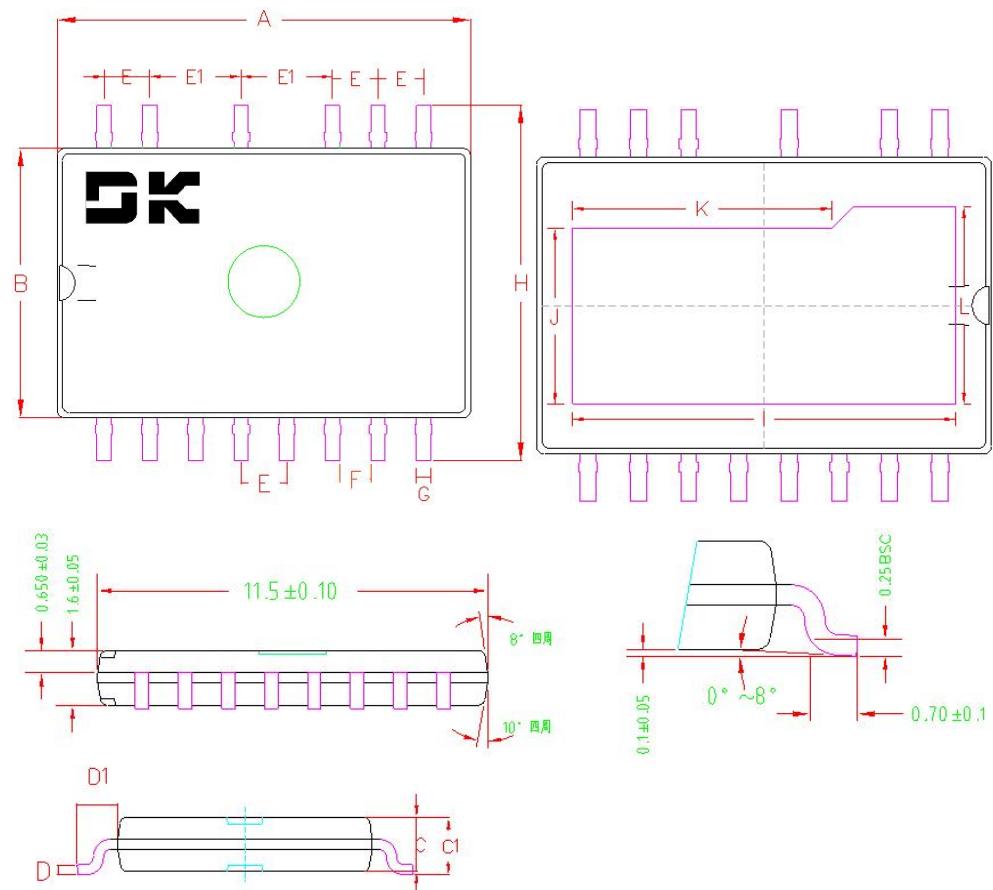
芯片内置过温保护电路，芯片检测到温度超过 $T_{otp(in)}$ ，芯片关闭 PWM 输出；芯片检测到温度低于 $T_{otp(out)}$ ，重新进入输入电压上电检测。

STOP 模式

当芯片检测到 OCP2 和旁路二极管短路时，芯片会进入 STOP 模式，等待 T_{stop} 时间后，重新进入输入电压上电检测。

封装外形及尺寸图：

ESOP16L 封装外形尺寸图



Symbol	Dimensions In Millimeters		
	Min	NOM	Max
A	11.40	11.50	11.60
B	7.40	7.50	7.60
C	1.55	1.60	1.65
C1	1.65	1.70	1.75
D	0.30 (BSC)		
D1	1.10	1.20	1.30
E	1.27 (BSC)		
E1	2.54 (BSC)		
F	0.75	0.80	0.85
G	0.40	0.42	0.45
H	9.80	10.00	10.20
I	9.60	9.70	9.80
J	4.35	4.45	4.55
K	6.47	6.57	6.67
L	4.90	5.00	5.10

东科半导体（安徽）股份有限公司

地址：中国安徽省马鞍山经济技术开发区金山西路 230 号 东科半导体产业园

电话：0555-2106566

传真：0555-2405666

网址：[http:// www.dkpower.cn](http://www.dkpower.cn)

华东/华北/华中/西南区技术服务公司：

东科半导体(安徽)股份有限公司无锡分公司

地址：中国江苏省无锡市滨湖区建筑西路 599 号 1 号楼 217

电话：0510-85386118

传真：0510-85389917

华南区技术服务公司：

东科半导体科技（深圳）有限公司

地址：深圳市宝安区福海街道桥头社区福海信息港 A2 栋四楼

电话：0755-29598396

传真：0755-29772369



注意：本产品为静电敏感元件，请注意防护！ESD 损害的范围可以从细微的性能下降扩大到设备故障。精密集成电路可能更容易受到损害，因此可能导致元件参数不能满足公布的规格。

- 感谢您使用本公司的产品，建议您在使用前仔细阅读本资料。
- 东科半导体（安徽）股份有限公司保留更改规格的权利，恕不另行通知。
- 东科半导体（安徽）股份有限公司对任何将其产品用于特殊目的的行为不承担任何责任。
- 东科半导体（安徽）股份有限公司没有为用于特定目的产品提供使用和应用支持的义务。
- 东科半导体（安徽）股份有限公司不会转让其专利许可以及任何其他的相关许可权利。
- 任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能，买方有责任在使用东科半导体（安徽）股份有限公司产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施，以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生！
- 产品提升永无止境，我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品